

Wirtschaftspatent

Erteilt gemäÙ § 29 Absatz 1 des Patentgesetzes

ISSN 0433-6461

(11)

0153 497

Int.Cl.³

3(51) C 23 C 15/00

AMT FUER ERFINDUNGS- UND PATENTWESEN

(21) WP C 23 C/ 218 956 (22) 08.02.80 (45) 13.01.82

- (71) VEB ELEKTROMAT IM VEB KOMBINAT MIKROELEKTRONIK 8080 DRESDEN;DD;
(72) RUDAKOFF, GEORG,PROF.DR. HABIL,DIPL.-CHEM.;TILLER, HANS-J.,DR. SC.DIPL.-PHYS.;
GOEBEL, ROLAND,DIPL.-PHYS.;VOIGT, REINHARD,DIPL.-PHYS.;DD;
SCHADE, KLAUS,DR. DIPL.-ING.;KOSCH, WOLFGANG;GEHMLICH, KONRAD,DIPL.-PHYS.;DD;
(73) siehe (72)
(74) VEB ZENTRUM FUER FORSCHUNG UND TECHNOLOGIE, 8080 DRESDEN, KARL-MARX-STRASSE

(54) VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUM PLASMAAETZEN ODER ZUR PLASMA CVD

(57)Die Erfindung dient zum plasmachemischen Aetzen oder reaktiven Ionenaetzen von Halbleitern und deren Verbindungen, Metallen, Glaesern und keramischen Erzeugnissen sowie organischen Materialien oder zur Plasma CVD. Ziel der Erfindung ist es, eine hoehere Arbeitsproduktivitaet bei der Bearbeitung von Halbleitersubstraten oder anderen fuer dieses Verfahren in Frage kommenden Materialien zu ermoeeglichen und gleichzeitig bei der Verwendung von Aetzgasen,die zur Verunreinigung des Reaktionsraumes durch Zersetzungsprodukte neigen,eine Verunreinigung zu vermeiden. Das Wesen der Erfindung besteht darin, daß das Plasma hauptsaechlich zwischen zwei oder mehreren in einem von den Entladungsbedingungen abhaengigen Abstand parallel zueinander angeordneten mit Substraten belegten Elektroden ausgebildet wird. Diese Elektroden sind gegenueber dem Rezipienten und/oder einer Hilfselektrode mit gleichem Potential beaufschlagt. -Figur 3-

218956 -1-

Verfahren und Vorrichtung zum Plasmaätzen oder zur Plasma CVD

Anwendungsgebiet der Erfindung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens zum plasmachemischen Ätzen oder reaktiven Ionenätzen von Halbleitern und deren Verbindungen, Metallen und Metallverbindungen, Gläsern und keramischen Erzeugnissen sowie organischen Materialien wie zum Beispiel Fotolack und zur Plasma CVD von Halbleitern, Halbleiterverbindungen, Metallen und Metallverbindungen.

Charakteristik der bekannten technischen Lösungen

Verfahren zum plasmachemischen Ätzen und zur Plasma CVD von Halbleitern und deren Verbindungen sind bekannt. Dabei wird das zu behandelnde Material in einen Rezipienten auf einer als Elektrode ausgebildeten Halterung postiert, ein Reaktionsgas in den Rezipienten eingeleitet und durch Erregung der Elektroden ionisiert und ein Plasma ausgebildet. Dabei ist zu der als Halterung ausgebildeten Elektrode zu- meist in einem gewissen Abstand parallel eine Gegenelektrode angeordnet. Es sind vier grundsätzliche Elektrodenanordnungen für die Hochfrequenzentladung bekannt.

Anordnungen, bei denen eine Elektrode auf Massepotential liegt und die Substrate auf der "heißen" Elektrode angeordnet sind, werden in den US P 3971684; 3984301; 3994793 und in der DE - AS 2449731 beschrieben.

In der DE-OS 2730156 und in der US P 3757733 sind Anordnungen beschrieben, bei denen die Substrate auf einer Masseelektrode liegen, wobei die heiße Elektrode innerhalb oder außerhalb des Rezipienten angeordnet ist. Gleiche Anordnungen sind auch aus den DE-OS 2730156 und 2708720 bekannt, bei denen jedoch die Substrate oder die Elektrode gefloatet sind. Aus der DE-OS 2800180 ist eine Anordnung bekannt, bei der über eine variable Impedanz eine Vorspannung an die Zielelektrode angeschlossen wird.

Diese beschriebenen Anordnungen werden zur Erzielung einer größeren Homogenität des Ätzprozesses dahingehend modifiziert, daß durch besondere Gestaltung der Elektrodenform (DE-OS 2241229), durch Einbringen eines geeignet gestalteten Dielektrikums (zum Beispiel DE-OS 2708720), oder durch Bewegung der Substrate (zum Beispiel DE-AS 2757498) räumlich oder zeitlich homogene Potential- beziehungsweise Gasströmungsverhältnisse geschaffen werden. Die beschriebenen Anordnungen sind alle sowohl vom elektrischen als auch vom mechanischen Aufbau her unsymmetrisch, wodurch Potentialinhomogenitäten entstehen, so daß jeweils nur begrenzte Bereiche einer Elektrodenfläche zur Substratbehandlung herangezogen werden können.

Außerdem können diese unsymmetrischen Anordnungen bei der Verwendung von Ätzgasen, die zur Verunreinigung des Reaktionsraumes durch Zersetzungsprodukte neigen, zur Schichtabscheidung auf einer Elektrode führen. Dadurch werden die Substrate einem erhöhten Verunreinigungsrisiko ausgesetzt. Als weiterer Nachteil ist die Inhomogenität in der Temperaturverteilung und damit eine Inhomogenität in der bekannterweise temperaturabhängigen Ätzrate zu sehen. Ferner ergeben die einfachen unsymmetrischen Diodenanordnungen eine Entladung von relativ niedrigem Ionisationsgrad, so daß bei relativ hohen Druckwerten gearbeitet

werden muß. Daraus resultieren geringe freie Weglängen, die einer Homogenisierung des Ätzeffektes ebenfalls entgegenstehen.

Ziel der Erfindung

Ziel der Erfindung ist es, eine höhere Arbeitsproduktivität bei der Bearbeitung von Halbleitersubstraten oder anderen für dieses Verfahren in Frage kommenden Materialien zu ermöglichen und gleichzeitig bei der Verwendung von Ätzgasen, die zur Verunreinigung des Reaktionsraumes durch Zersetzungsprodukte neigen, eine Verunreinigung zu vermeiden.

Darlegung des Wesens der Erfindung

Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, die bekannten Plasmaverfahren zur Bearbeitung von Substraten dahingehend zu verbessern, daß eine homogene Verteilung der Ätzrate erreicht wird und die für dieses Verfahren erforderliche Veränderungen an den bekannten Vorrichtungen anzugeben.

Erfindungsgemäß wird die Aufgabe dadurch gelöst, daß das Plasma hauptsächlich zwischen zwei oder mehreren in einem von den Entladungsbedingungen abhängigen Abstand parallel zueinander angeordneten mit Substraten belegten Elektroden ausgebildet wird, die gegenüber dem Rezipienten und/oder einer Hilfselektrode mit gleichem Potential beaufschlagt werden.

Die bekannten Plasmaätzvorrichtungen werden zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens dahingehend verändert, daß die beiden parallel zueinander angeordneten Elektroden aus fest oder beweglich im Rezipienten angeordneten Platten, die auf den zueinanderweisenden Flächen mit Substraten belegbar sind, bestehen und beide Platten an das gleiche Potential des HF-Generators gelegt sind. Vorteilhafterweise sind dabei beide Elektroden leitend

miteinander verbunden. Zwecks einer günstigen automatischen Be- und Entladung des Reaktionsraumes ist die Elektrodeneinheit als schleusbare Kassette ausgebildet. Nach einer weiteren vorteilhaften Ausführung sind die mechanisch voneinander unabhängigen leitend miteinander verbundenen Elektroden oder Kassetten stapelförmig in der Anlage angeordnet.

Diese elektrisch wie mechanisch symmetrischen Ätzanordnungen bewirken gegenüber den bekannten asymmetrischen Ätzanordnungen eine grundsätzlich andere, gleichmäßige und intensive Plasmaentladung. Durch die über die Elektrodenflächen homogene Plasmaverteilung wird der durch das Plasma bedingte Wärmefluß zu den Elektroden und damit die daraus resultierende Temperaturverteilung räumlich homogen. Dadurch kann ein größerer Anteil der Elektrodenfläche mit Substraten belegt werden als bisher, beziehungsweise es entfallen aufwendige Varianten einer Substratbewegung zur Homogenisierung. Da außerdem beide Parallelplatten bei der erfindungsgemäßen Lösung mit Substraten belegt werden, erhöht sich die Arbeitsproduktivität gegenüber den bekannten Vorrichtungen wenigstens um das Doppelte.

Die erfindungsgemäßen Elektrodenausführungen ermöglichen eine lokalisierte Plasmaentladung in wesentlich niedrigeren Druckbereichen als asymmetrische Anordnungen, ohne daß dazu Abschirmungen erforderlich sind. Bei diesem niedrigen Arbeitsdruck wird durch die wesentlich vergrößerte freie Weglänge im Reaktionsgas eine entscheidende (zusätzliche) Verbesserung der Homogenität erreicht. Bei Verwendung von Fluor- oder Chlor-Kohlenwasserstoffen als Prozeßgase fallen höhermolekulare Verbindungen als Reaktionsprodukte an, die sich bei den bekannten unsymmetrisch aufgebauten Anordnungen in unterschiedlicher Weise im Substratbereich abscheiden. Das erfindungsgemäße Verfahren gestattet eine Optimierung der Plasmaabscheidung dergestalt, daß im gesamten Substratbereich eine Abscheidung derartiger Produkte vermieden wird.

Ausführungsbeispiel

Die Erfindung wird an Hand einer Zeichnung näher erläutert. Dabei zeigt:

Fig. 1 einen schematischen Aufbau eines Rezipienten mit Parallelplattenelektrode

Fig. 2 einen Rezipienten mit Kassettenelektrode

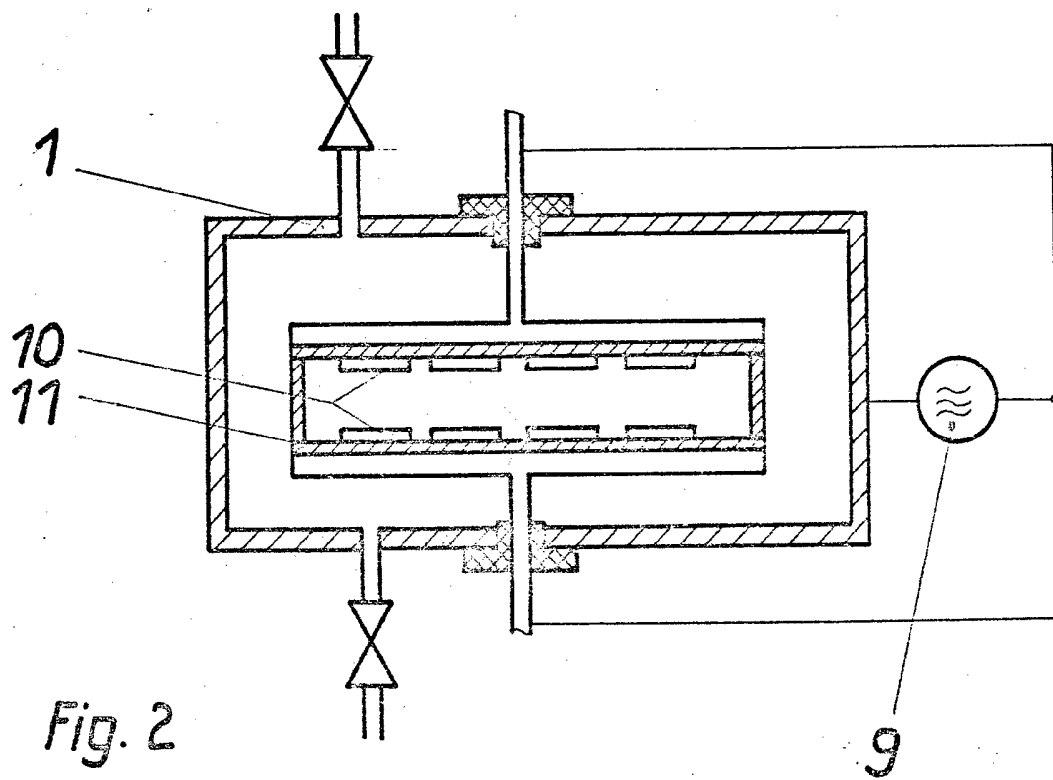
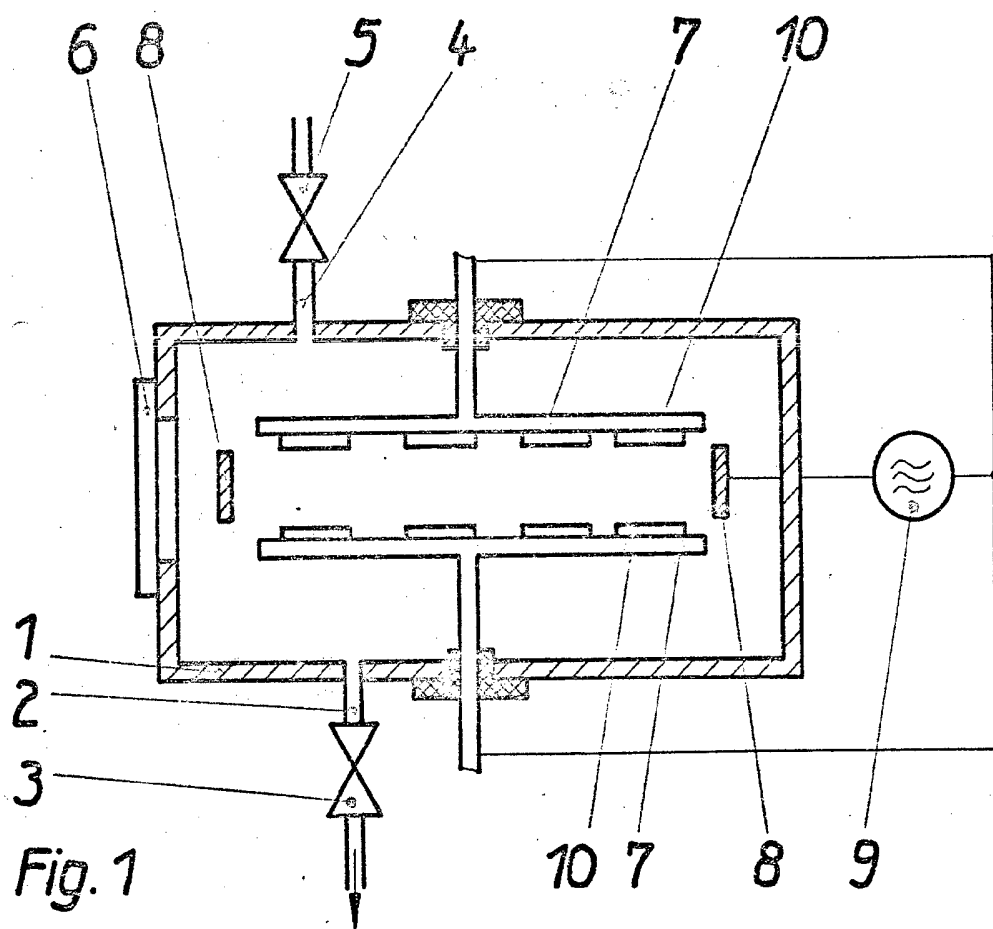
Fig. 3 einen Rezipienten mit stapelförmig angeordneten Kassettenelektroden.

In den Rezipienten 1 wird das Plasma hauptsächlich zwischen zwei oder mehreren in einem von den Entladungsbedingungen abhängigen Abstand parallel zueinander angeordneten Elektroden ausgebildet. Diese werden gegenüber dem Rezipienten 1 oder einer Hilfselektrode 8 mit gleichem Potential beaufschlagt. Dabei sind die Elektroden auf den zueinanderweisenden Flächen mit Substraten 10 belegt. In Fig. 1 sind die beiden Elektroden 7 als zwei parallel zueinander angeordneten und mit Substraten 10 belegten Platten dargestellt. Beide Elektroden 7 sind gegenüber der Hilfselektrode 8 auf gleiches Potential gelegt. Der Rezipient 1 ist mit einer Saugleitung 2 und einer Gasversorgungsleitung 4 versehen. Die dazugehörigen Absperrventile sind mit 3 und 5 bezeichnet. Zur Einbringung der Substrate 10 in den Rezipienten 1 ist eine Beschickungsluke 6 vorgesehen. Der HF-Generator ist mit 9 bezeichnet. Zwecks einer günstigen automatischen Be- und Entladung des Reaktionsraumes des Rezipienten 1 ist in Fig. 2 die Elektrodeneinheit als schleusbare Kassette 11 dargestellt. Eine weitere vorteilhafte Ausführungsform der Elektroden 7 zeigt die Fig. 3. Hierbei sind zur gleichzeitigen Bearbeitung im Rezipienten 1 die Kassetten 11 stapelförmig angeordnet. Zur Gewährleistung der Einstellbarkeit und Gleichmäßigkeit der Temperatur sind die Kassetten 11 in wahlweise heiz- beziehungsweise kühlbaren Halterungen 12 angeordnet. Die Halterung 12 ist dabei mit dem HF-Generator 9 verbunden.

Die in den Fig. 1 bis 3 dargestellten Elektrodenanordnungen stellen elektrisch wie mechanisch symmetrische Anordnungen dar, die eine intensive und gleichmäßige Plasmaentladung über die gesamten Elektrodenflächen ermöglichen.

Erfindungsanspruch

1. Verfahren zum Plasmaätzen oder zur Plasma CVD in einem Rezipienten, in dem zwischen zwei Elektroden ein Plasma ausgebildet wird, gekennzeichnet dadurch, daß das Plasma hauptsächlich zwischen zwei oder mehreren in einem von den Entladungsbedingungen abhängigen Abstand parallel zueinander angeordneten mit Substraten belegten Elektroden ausgebildet wird, die gegenüber dem Rezipienten und/oder einer Hilfselektrode mit gleichem Potential beaufschlagt werden.
2. Vorrichtung zum Plasmaätzen oder zur Plasma CVD, bestehend im wesentlichen aus einem mit Elektroden ausgerüsteten Rezipienten, HF-Generator, Vakuumpumpe und Gaszuleitung, insbesondere zur Durchführung des Verfahrens nach Punkt 1, gekennzeichnet dadurch, daß die beiden parallel zueinander angeordneten Elektroden aus fest oder beweglich im Rezipienten angeordneten Platten, die auf den zueinanderweisenden Flächen mit Substraten belegbar sind, bestehen und beide Platten an das gleiche Potential des HF-Generators gelegt sind.
3. Vorrichtung nach Punkt 2, gekennzeichnet dadurch, daß die beiden Elektroden leitend miteinander verbunden sind.
4. Vorrichtung nach Punkt 2 und 3 gekennzeichnet dadurch, daß die beiden Elektroden als schleusbare Kassette ausgebildet sind.
5. Vorrichtung nach Punkt 2 bis 4 gekennzeichnet dadurch, daß die mechanisch voneinander unabhängigen elektrisch leitend miteinander verbundenen parallelen Elektroden oder Kassetten stapelförmig in der Anlage angeordnet sind.



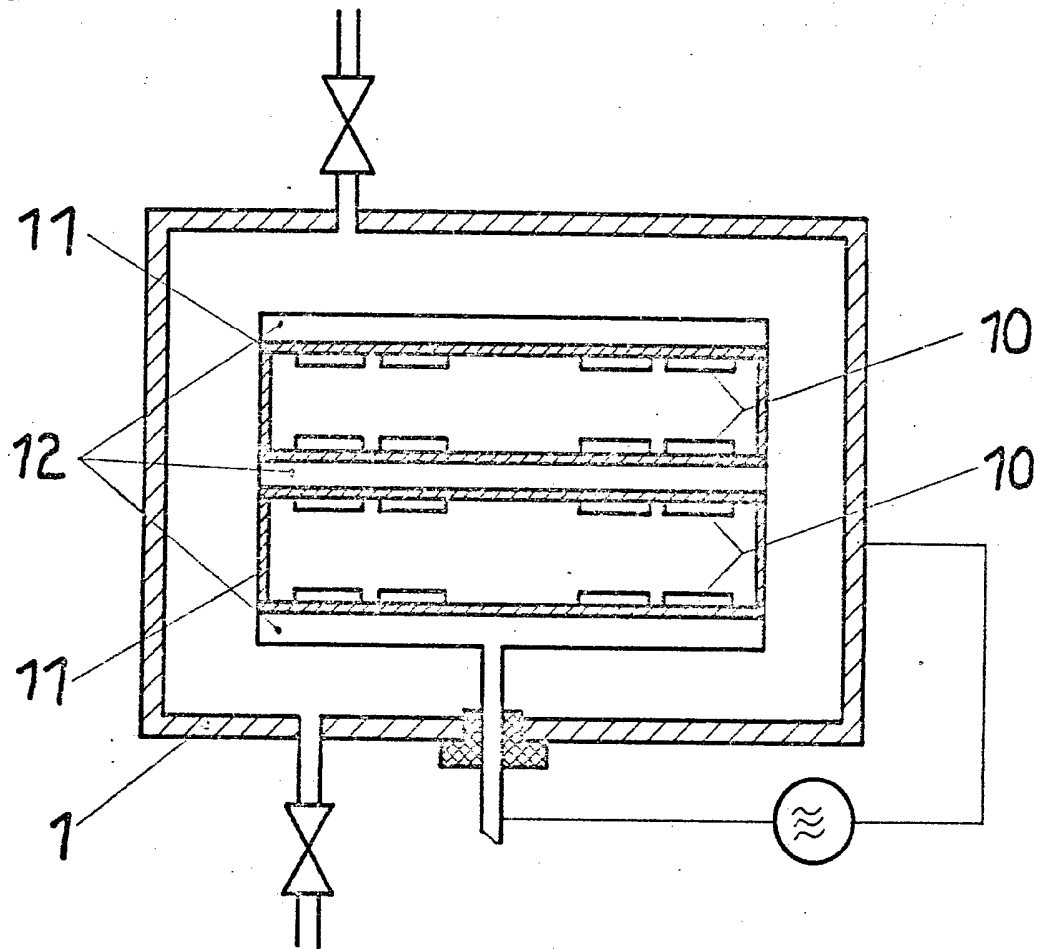


Fig. 3